

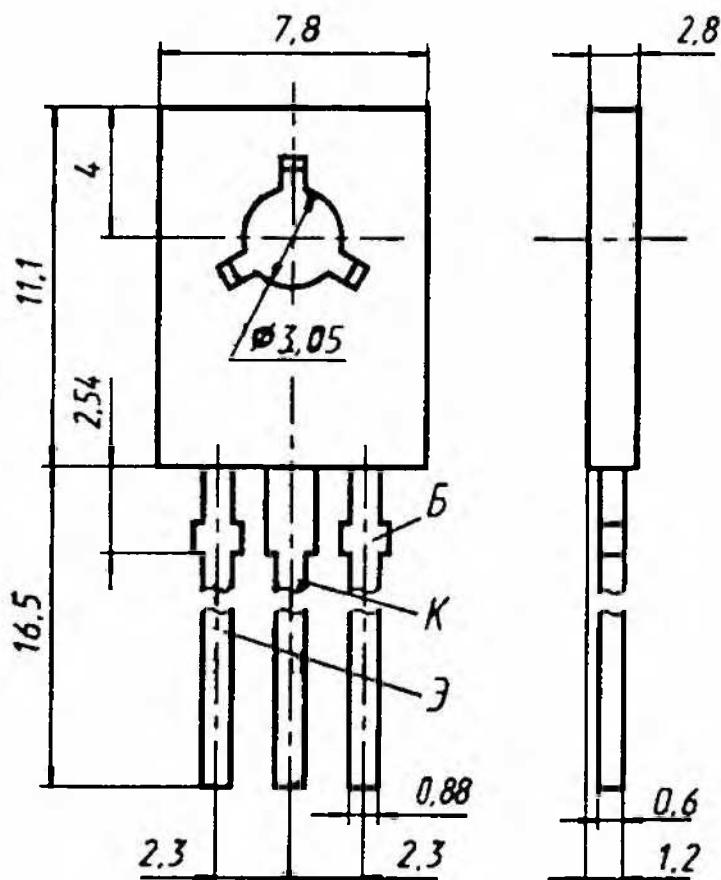
KT8130A, KT8130B, KT8130В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $p-n-p$ составные усиительные. Предназначены для применения в усилителях мощности и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний»,
г. Брянск.

KT8130(A-B)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока

в схеме ОЭ при $U_{KB} = 3$ В:

$I_3 = 0.5$ А	500...15000*
$I_3 = 2$ А	750...15000*
$I_3 = 4$ А	100...15000*

Граничная частота коэффициента передачи
тока в схеме ОЭ при $U_{KB} = 10$ В, $I_3 = 0.5$ А,

не менее 25 МГц

Граничное напряжение при $I_3 = 0.1$ А,

не менее:

KT8130A 40 В

KT8130Б	60 В
KT8130В	80 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер,
не более:

при $I_K = 2 \text{ A}$, $I_B = 8 \text{ mA}$	2 В
при $I_K = 4 \text{ A}$, $I_B = 40 \text{ mA}$	3 В

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:

KT8130А	40 В
KT8130Б	60 В
KT8130В	80 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер

при $R_{B3} = 1 \text{ кОм}$:

KT8130А	40 В
KT8130Б	60 В
KT8130В	80 В

Постоянное напряжение база—эмиттер

5 В

Постоянный ток коллектора

4 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллек-
тора при $T_K = -45 \dots +25^\circ\text{C}$

20 Вт

Температура p - n перехода

$+150^\circ\text{C}$

Температура окружающей среды

$-45 \dots T_K =$

$= +100^\circ\text{C}$

Транзисторы являются комплементарными с транзистора-
ми KT8131A—KT8131B.